

(79)

二段脱P法の50t LDへの適用について

溶銑予備脱Pに関する研究(II)

新日鐵室蘭

伊藤幸良

岡島忠治

河内雄二

桑原達朗

岩田健雄

○高橋紀夫

1. 緒言

前報において、300kg炉の試験結果から溶銑の優先脱P法として、脱Si～排滓～脱Pからなる二段脱P法が低P化に対して極めて有効であることを報告した。本報では50t LDでおこなつた二段脱P法のスケール・アップ試験の結果について報告する。

2. 試験方法

基本的な吹鍊パターンは300kg炉の場合と同様である。以下各ステップでの概要を述べる。

- (1) 脱Si期 — 転炉吹鍊ではSi ≈ 0.20%で脱O反応が開始するため吹止Si ≈ 0.20%を目標とした。
- (2) 排滓 — 出鋼～排滓法による。
- (3) 脱P期 — 転炉での優先脱Pを吹酸条件、温度条件から探索した。(ボトムバーリングなし)
又脱P剤は300kg炉と同様CaO, Fe₂O₃, CaF₂の混合物を用いた。

3. 試験結果

大型炉(50t LD)における二段脱P法について次の結果を得た。

- (1) 脱Si期 — 脱O抑制のため吹止Si ≈ 0.20%を目標とし、送酸速度およびSiの酸素消費効率から処理時間をコントロールでき、脱O量は0.30%以下に抑制可能である。このステップでの脱P反応はほとんど進行しない。
- (2) 脱P期 — 優先脱Pの条件を吹酸、温度の面から検討した結果、脱C抑制のためには酸素ジェットによるキャビティ深さを制御しても効果はなく、むしろ送酸速度を小さくすることの方が有効であった。一方脱Pに関しては図1に示すようにランス高さが高いほど反応が促進される。又温度条件については図2に示すように脱P剤の活性化及び脱P平衡の両面から吹止温度に関して最適温度範囲(1380～1480°C)が存在することがわかる。

図3には本試験での成分挙動の代表例を示した。このチャージでの吹鍊条件は脱Si期：吹酸速度10700Nm³/Hr, ランス高さ1100mm, 脱P期：吹酸速度4200Nm³/Hr, ランス高さ2000mm, L=7mm, スクラップ投入量25tであった。このように吹鍊条件をコントロールすることで脱O量を13%に抑制し処理時間わずか10分でPを0.120%→0.010%以下に低下させることが可能である。

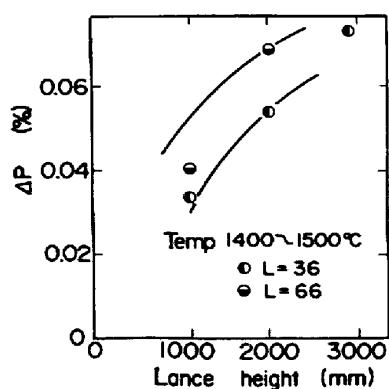


図1 ランス高さと脱P量の関係

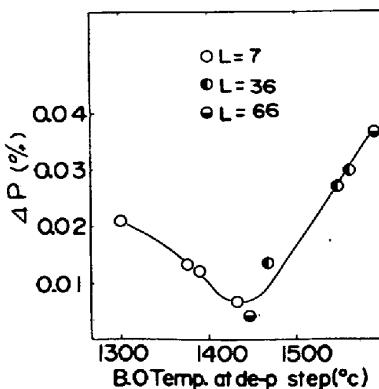


図2 吹止温度と到達Pの関係

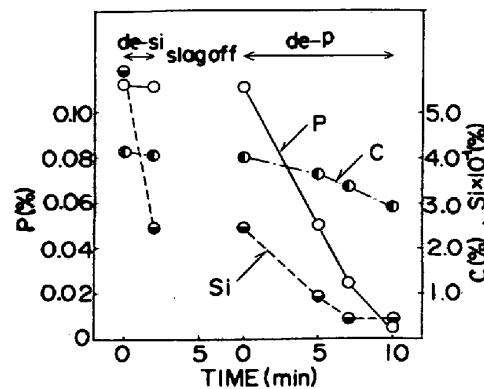


図3 成分挙動の代表例